

## ВЫБОР – ЗА ВАМИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Расскажите, пожалуйста, про военную кафедру.

– В МИФИ, наряду с 23 вузами России, имеется военная кафедра. Набор на нее осуществляется после третьего курса. План приема составляет 160 человек. Существует достаточно значительный конкурс. В соответствии с законом, который начал действовать с 1 января, лица, окончившие военную кафедру и аттестовавшиеся как офицеры, не подлежат призыву, кроме военного времени, то есть становятся офицерами запаса.

– Можно ли поступать на два факультета? Как подстраховаться, если не пройдешь на желаемый факультет и поступать на другой?

– Можно поступать на два факультета. Но заявление пишется на тот, на который вы хотите поступить. При этом указываете в порядке приоритета, на какие факультеты хотите быть зачислены в случае непрохождения по конкурсу, включая платные формы обучения.

– Какова роль пробных экзаменов по физике и математике, если принимаются только результаты ЕГЭ и олимпиады?

– Те, кто на пробных экзаменах набирает семь и более баллов, допускаются к заключительному туру олимпиады Росатома, результаты которой могут быть засчитаны в качестве вступительных экзаменов.

– Можно ли пересдать ЕГЭ в МИФИ?

– Считается, что, сдав в текущем году ЕГЭ вы использовали свою попытку поступления, и повторная сдача не допускается.

*После завершения встречи в актовом зале абитуриенты и их родители могли более подробно узнать о каждом факультете от их деканов.*

Материал подготовили  
П. Калмыков,  
Ирина Шальнова,  
С. Сергеева.

Высший физический колледж Российской академии наук и Федерального агентства по образованию создан в МИФИ в 1991 г. с целью совершенствования высшего физического образования, обеспечения дополнительных условий для развития творческих способностей одаренных студентов и подготовки их для учебы в аспирантуре и последующей научной работы в научных исследовательских институтах Академии наук и в международных научных центрах. История создания колледжа связана с открытием в 1986 г. высокотемпературной сверхпроводимости, за которым во всем мире последовал настоящий бум в физике конденсированного состояния. Для осуществления целенаправленной подготовки специалистов и пополнения научных академических школ в этой области исследований, а также в других перспективных научных направлениях совместным решением Президиума Академии наук и коллегии Государственного комитета по народному образованию на базе ведущих вузов России были образованы три колледжа: Высший колледж в области наук о материалах – в МГУ, Высший химический колледж – в МХТИ им. Д.И. Менделеева и Высший физический колледж – в МИФИ.

В состав Попечительского совета колледжа, возглавляемого президентом Российского научного центра «Курчатовский институт», академиком Е.П. Велиховым входят академики К.А. Валиев, Ю.А. Осипьян, Ю.В. Гуляев, В.П. Смирнов, члены-корреспонденты РАН М.В. Ковальчук, Н.А. Черноплёков, И.А. Шербаков, которые являются директорами и научными руководителями ведущих академических институтов.

По решению Попечительского совета колледж готовит специалистов в области взаимодействия концентрированных потоков излучения с веществом, лазерной физики, физики сверхпроводимости, физики наноструктур, неравновесных твердотельных структур, микроэлектроники, физики плазмы, микро- и космофизики, релятивистской ядерной физики и по другим приоритетным направлениям физики. Выбранные направления обеспечивают возможность подготовки

## ВЫСШИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

специалистов на стыке наук и предусматривают одновременное взаимодействие нескольких выпускающих кафедр и академических институтов.

Обучение ведется по сложным программам изучения фундаментальных наук – на младших курсах и по индивидуальным планам – на старших. Кроме глубокой подготовки в области физики, математики, теоретической физики большое внимание уделяется компьютерной подготовке, изучению языков и гуманитарным наукам. Выпускник колледжа должен знать два языка: английский в совершенстве и еще один из европейских языков (немецкий или французский) – по выбору. Традиционно более трети выпускников заканчивают институт с отличием.

**Выпускники колледжа получают диплом МИФИ и продолжают учебу в аспирантуре МИФИ и академических институтов или научную работу в международных научных центрах.**

Выпускники колледжа отличаются высоким уровнем фундаментальных знаний в математике и физике, а также умением использовать современные наукоемкие и информационные технологии как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. Колледж имеет свой компьютерный класс, в котором не только проводятся занятия по машинной графике, компьютерному моделированию физических процессов, численным методам в математике и физике, но и предоставляется свободный доступ для работы студентов в сети Интернет во внеучебное время.

Учебно-научной базой колледжа является учебно-научная база МИФИ, а также научных лабораторий академических институтов и РНЦ «Курчатовский институт».

Выпуск специалистов в рамках Высшего физического колледжа осуществляется выпускающими кафедрами: **лазерной физики** (заведующий кафедрой – д.ф.-м.н., профессор Е.Д. Проценко), **сверхпроводимости и физики наноструктур** (заведующий кафедрой – д.ф.-м.н., профессор В.Ф. Елесин), **физики**

плазмы (заведующий кафедрой – д.ф.-м.н., профессор В.А. Курнаев), **экспериментальной ядерной физики и космофизики** (заведующий кафедрой – д.ф.-м.н., профессор В.В. Дмитриенко), **микро- и нанотехнологий** (заведующий кафедрой – д.ф.-м.н., профессор В.С. Першков).

На разных этапах обучения в подготовке специалистов, кроме выпускающих кафедр, активно участвуют кафедры высшей математики, общей физики, теоретической ядерной физики, радиационной биофизики, физики и экологии, общей химии, инженерной графики, электротехники, электроники, иностранных языков, а также кафедры общественных наук (истории, философии, социологии и экономики).

Начиная с третьего курса студенты колледжа занимаются учебно-исследовательской работой, проходят преддипломную практику и дипломное проектирование на базе научных лабораторий институтов – попечителей колледжа: Института физики твердого тела РАН, Физико-технологического института РАН, Института общей физики РАН, Института радиотехники и электроники РАН, Института кристаллографии РАН, Института ядерного синтеза и Института сверхпроводимости и физики твердого тела РНЦ «Курчатовский институт».

Высочайший научно-педагогический уровень преподавательского коллектива колледжа регулярно подтверждается большим числом научных грантов, получаемых от отечественных и зарубежных фондов, таких как Российский фонд фундаментальных исследований, программы Минобрнауки РФ, грант Москвы для ведущих профессоров, доцентов, аспирантов и студентов (в колледже преподают 12 профессоров и доцентов – лауреатов гранта Москвы, более 15 студентов и выпускников также являются лауреатами этого гранта для студентов и аспирантов).

Профессора, преподаватели, ученые и аспиранты выполняют совме-



стные научные исследования с рядом зарубежных научных центров и университетов, среди которых Университет г. Гренобля (Франция), Национальный синхротронный центр MAX-lab (Швеция), Научный центр DESY (Германия), Институт Макса Планка (Германия), Университет г. Осло (Норвегия), Университет г. Оксфорд (Англия) и др. Многие студенты и выпускники колледжа проходят научную стажировку и с успехом работают в научных центрах и университетах США, Германии, Франции, Англии, Швеции, Италии и Японии.

**Набор в Высший физический колледж осуществляется в два этапа:**

- **на первый курс** – из выпускников физико-математических лицеев МИФИ №1511, №1523, школы №978 и подготовительного факультета на конкурсной основе;

- **на второй курс** – из студентов всех дневных факультетов МИФИ после окончания первого курса на конкурсной основе.

Дорогие абитуриенты!

Система обучения в Высшем физическом колледже МИФИ позволит развить ваши способности и реализовать ваши творческие возможности.

Не упустите свой шанс.

**А.П. Менушенков,**  
декан  
Высшего физического колледжа,  
доктор физико-математических наук,  
профессор.

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

*Основная задача подготовительного факультета – повышение уровня знаний учащихся школ и средних специальных учебных заведений, создание условий для поступления и успешного их обучения в МИФИ.*

Структура факультета позволяет реализовать подготовку учащейся молодежи по различным формам, учитывая склонности и возможности потенциальных абитуриентов.

**Дневная очная подготовка** реализуется на базе лицеев №1511, №1523, №1547 и школы №978 при МИФИ, а также лицейских классов на базе школ №1828 «Сабурово», №983 (м. «Кантемировская»), №980 (м. «Красногвардейская»), №1881 (м. «Марьино»), №1971 (Южное Бутово). В лицеях и лицейских классах обучаются школьники 8–11-х классов по физико-математическому и гуманитарному направлениям довузовской подготовки. Набор учащихся на конкурсной основе в лицеи и в лицейские классы проводится ежегодно: в марте – в 9-е и 10-е, в мае – в 8-е классы.

**Вечерняя очная подготовка** по физико-математическому и гуманитарному направлениям в форме подготовительных курсов осуществляется на базе лицеев (для 7–9-х классов), на базе университета и



школы №978 при МИФИ (для 10–11-х классов, учащихся колледжей и техникумов), а также на базе 30 школ Москвы и Московской области, имеющих соответствующие договоры с МИФИ. Прием заявлений от учащихся – в сентябре и в январе.

**Заочная подготовка** организуется для иногородних учащихся (7–11-е классы) по различным направлениям. Заявления в заочную школу МИФИ принимаются с сентября по май.

*Более подробную информацию можно получить по телефону: (495) 324-60-40.*

**Ю.В. Самоваршиков,**  
декан подготовительного факультета,  
заслуженный учитель РФ.

Без малого шестьдесят лет в нашем вузе осуществляется подготовка специалистов для научных учреждений, производственных предприятий и других организаций различных форм собственности по очно-заочной (вечерней) форме обучения. Такое обучение дает возможность получения престижного образования по новейшим направлениям науки и техники без отрыва от производства, что особенно ценно в нынешних условиях.

Лица, зачисленные на специальности «Электроника и автоматика физических установок», «Физика конденсированного состояния вещества», «Ядерные реакторы и энергетические установки», имеют возможность в течение шести лет получить квалификацию инженера-физика. За время учебы студенты получают фундаментальную физико-математическую подготовку, компьютерное и общеинженерное образование, изучают широкий круг экономических дисциплин, специализируются в области новейших достижений экспериментальной физики. Полученные знания позволяют выпускникам факультета успешно работать как в избранных направлениях деятельности, так и в смежных областях науки и техники.

Выпускники техникумов и колледжей, получившие подготовку по вычислительной технике, программированию, автоматизированным системам управления, автоматике, микроэлектронике и радиотехнике, зачисляются в группы с сокращенным сроком обучения (четыре года) при условии поступления на родственную специальность. По окончании обучения им присваивается квалификация инженера или инженера-физика.

Помимо бюджетного обучения на факультете имеется обучение на платной (контрактной) основе.

Выпускникам техникумов компьютерного профиля предлагается ускоренная подготовка на контрактной (платной) основе по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Обучение будущих инженеров-системотехников организовано по двум специализациям: «Программное обеспечение вычислительных систем» и «Компьютерные технологии электронной коммерции».

## ФАКУЛЬТЕТ ОЧНО-ЗАОЧНОГО (ВЕЧЕРНЕГО) ОБУЧЕНИЯ

Для выпускников техникумов и колледжей экономико-информационной направленности организовано платное обучение в сокращенные сроки по специальности «Прикладная информатика в экономике» (специализация – «Информационный менеджмент», квалификация – информатик-экономист). Помимо базовой подготовки в области вычислительной техники и информационных технологий студенты изучают широкий круг дисциплин, связанных с маркетингом, менеджментом, рыночной экономикой и предпринимательской деятельностью. В учебном процессе по этому направлению принимают участие ведущие специалисты крупных коммерческих фирм и организаций. Обучение выпускников средних школ и непрофильных техникумов по этой специальности осуществляется в течение пяти лет.

Факультет очно-заочного (вечернего) обучения совместно с факультетом информационной безопасности осуществляет подготовку специалистов по специальности «Комплексная защита объектов информатизации» на контрактной основе. Выпускники данной специальности получают квалификацию специалиста по защите информации, позволяющую проектировать, внедрять и эксплуатировать специальные технические и программно-математические средства защиты информации на различных объектах информатизации. В подготовке будущих специалистов помимо профессорско-преподавательских кадров университета принимают участие ведущие специалисты зарубежных и отечественных фирм и компаний, успешно работающих на рынке информационных технологий. Продолжительность обучения – 5 лет.

На факультете возможно получение второго высшего образования по перечисленным специальностям и направлениям (сроки обучения: 2-3 года в зависимости от вида и уровня предыдущего образования).



Принимаются на факультет очно-заочного (вечернего) обучения лица со средним или среднетехническим образованием, проживающие в Москве или Московской области. Заявления принимаются в приемной комиссии института с 20 июня по 15 июля.

Зачисление абитуриентов, поступающих на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, осуществляется по результатам экзамена по математике (письменно) и испытания по русскому языку (изложение по системе «зачет» или «незачет»). Зачисление на платное обучение проводится по результатам письменного испытания по математике и изложения по русскому языку.

Дополнительные сведения о порядке приема на факультет очно-заочного (вечернего) обучения можно получить по телефонам: 324-71-04, 323-95-08.

**Б.Ф. Ануфриев,**  
декан факультета  
очно-заочного  
(вечернего) обучения.